



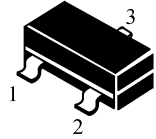
桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMBT4403(銷售型號 MMBT4403)

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

PNP Switching Transistor

■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V _{CEO}	-40	V _{dc}
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V _{CBO}	-40	V _{dc}
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V _{EBO}	-5.0	V _{dc}
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I _c	-600	mA _{dc}

■THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) T _A =25°C 環境溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P _D	225 1.8	mW mW/°C
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate, 氧化鋁襯底(2) T _A =25°C 環境溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P _D	300 2.4	mW mW/°C
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	R _{θJA}	417	°C/W
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T _J , T _{stg}	150°C, -55to+150°C	

■DEVICE MARKING 打標

GMBT4403(銷售型號 MMBT4403)=**2T**



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMBT4403(銷售型號 MMBT4403)

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

■OFF CHARACTERISTICS 截止電特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage(3) 集電極-發射極擊穿電壓($I_C=-1.0\text{mA}$, $I_B=0$)	$V_{(BR)CEO}$	-40	—	Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極基極擊穿電壓($I_C=-0.1\text{mA}$, $I_E=0$)	$V_{(BR)CBO}$	-40	—	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極基極擊穿電壓($I_E=-0.1\text{mA}$, $I_C=0$)	$V_{(BR)EBO}$	-5.0	—	Vdc
Base Cutoff Current 基極截止電流 ($V_{CE}=-35\text{Vdc}$, $V_{EB}=-0.4\text{Vdc}$)	I_{BEV}	—	-0.1	μA
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CE}=-35\text{Vdc}$, $V_{EB}=-0.4\text{Vdc}$)	I_{CEX}	—	-0.1	μA

- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
- Pulse Width≤300us;Duty Cycle≤2.0%.

■ON CHARACTERISTICS 導通電特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE}			—
($I_C=-0.1\text{mA}$, $V_{CE}=-1.0\text{Vdc}$)		30	—	
($I_C=-1.0\text{mA}$, $V_{CE}=-1.0\text{Vdc}$)		60	—	
($I_C=-10\text{mA}$, $V_{CE}=-1.0\text{Vdc}$)		100	—	
($I_C=-150\text{mA}$, $V_{CE}=-2.0\text{Vdc}$)(3)		100	300	
($I_C=-500\text{mA}$, $V_{CE}=-2.0\text{Vdc}$)(3)		20	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 ($I_C=-150\text{mA}$, $I_B=-15\text{mA}$) ($I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$	—	-0.4 -0.75	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降 ($I_C=-150\text{mA}$, $I_B=-15\text{mA}$) ($I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$)	$V_{BE(sat)}$	-0.75 —	-0.95 -1.3	Vdc



GMBT4403(銷售型號 MMBT4403)

■ **SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS** 小信號特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益帶寬乘積 ($I_C=-20\text{mA}$, $V_{CE}=-10\text{V}$, $f=100\text{MHz}$)	f_T	200	—	MHz
Collector-Base Capacitance 集電極基極電容 ($V_{CB}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{MHz}$)	C_{cb}	—	8.5	pF
Emitter-Base Capacitance 發射極基極電容 ($V_{BE}=-0.5\text{V}$, $I_C=0$, $f=1.0\text{MHz}$)	C_{eb}	—	30	pF
Input Impedance 輸入阻抗 ($I_C=-1.0\text{mA}$, $V_{CE}=-10\text{V}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{ie}	1.5	15	k Ω
Voltage Feedback Ratio 電壓反饋係數 ($I_C=-1.0\text{mA}$, $V_{CE}=-10\text{V}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{re}	0.1	8.0	$\times 10^{-4}$
Small-Signal Current Gain 小信號電流增益 ($I_C=-1.0\text{mA}$, $V_{CE}=-10\text{V}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{fe}	60	500	—
Output Admittance 輸出導納 ($I_C=-1.0\text{mA}$, $V_{CE}=-10\text{V}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{oe}	1.0	100	μmhos

■ **SWITCHING CHARACTERISTICS** 開關特性

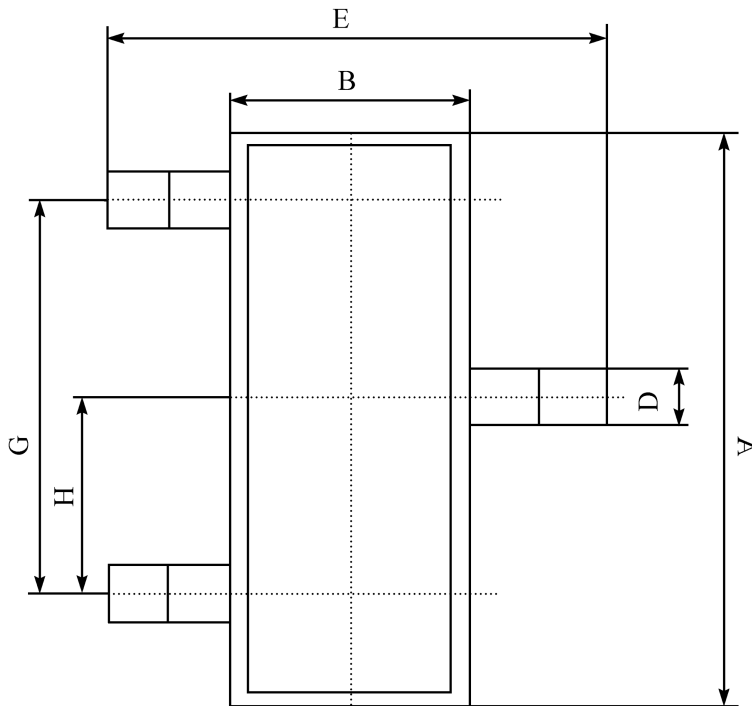
Delay Time 延遲時間	(V _{cc} =-30Vdc, V _{EB} =-2.0Vdc I _c =-150mA, I _{B1} =-15mA)	t_d	—	15	ns
Rise Time 上升時間		t_r	—	20	
Storage Time 儲存時間	(V _{cc} =-30Vdc, I _c =-150mA, I _{B1} =I _{B2} =-15mA)	t_s	—	225	ns
Fall Time 下降時間		t_f	—	30	



GMBT4403(銷售型號 MMBT4403)

■DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

